	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN037	文件编号	XS-W-155
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN037 封装的成品管主要用于电视机，收音机和玩具电路中。

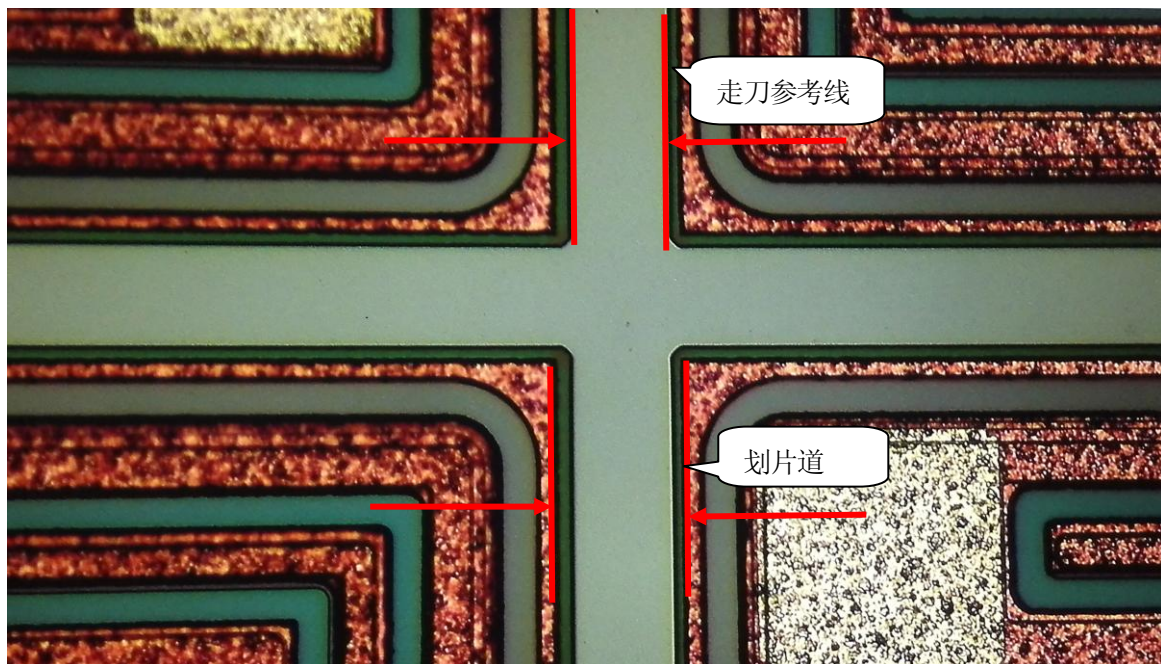
1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 击穿电压高

2 芯片数据


	芯片尺寸 (mm×mm)	0.41×0.41	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	≤180	
	划片道*尺寸 (μm)	40	
	键合区面积 (μm ²)	基区	89×91
		发射区	95×93
	钝化层	Si ₃ N ₄	
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	3.8±0.5
	背面电极金属	金	
	硅片直径 (mm)	φ125	
	装片要求 (推荐)	共晶	
	键合要求 (推荐)	铜丝: Φ32μm; E、B 区各一根	

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道两侧的铝条不断裂即判为合格。

江阴新顺微电子有限公司	
地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号	网 址: http://www.xs-elec.com
电 话: (0510) 86851182	传 真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN037	文件编号	XS-W-155
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

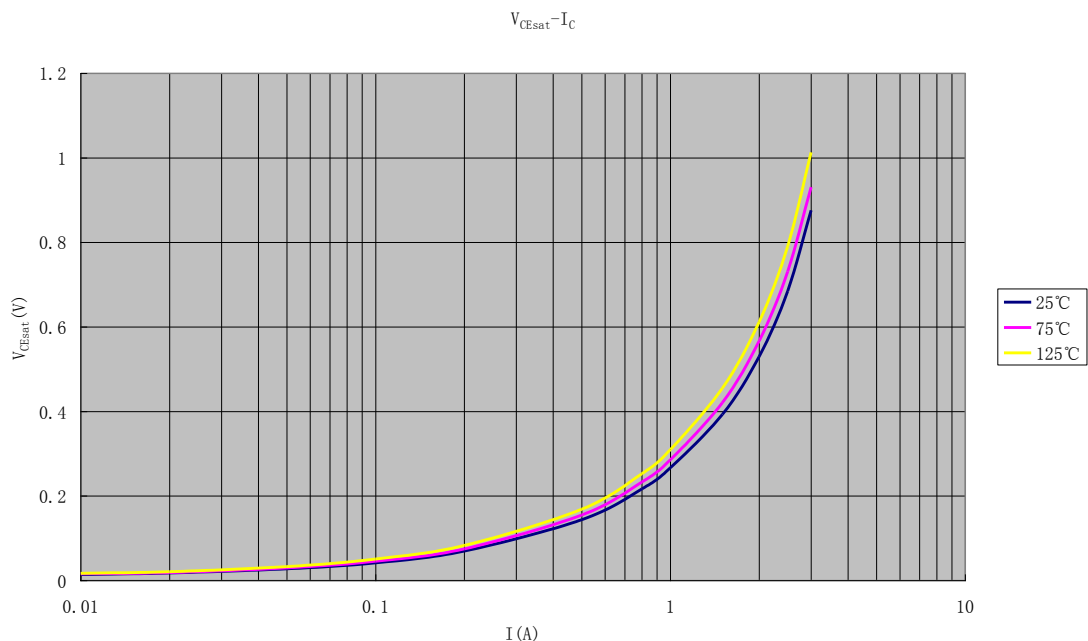
参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	40	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: S9013
集电极-发射极电压	V_{CE0}	25	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	5	V	
集电极电流	I_C	0.45	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.625	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=40\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=50\text{mA}$	60		320	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$			0.35	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=20\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$	150			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
传真: (0510) 86851532

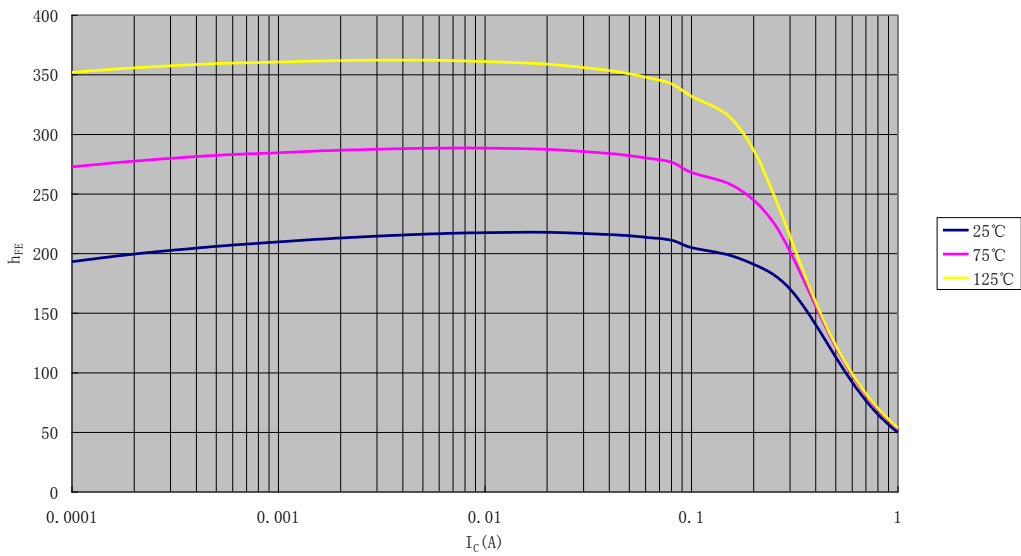
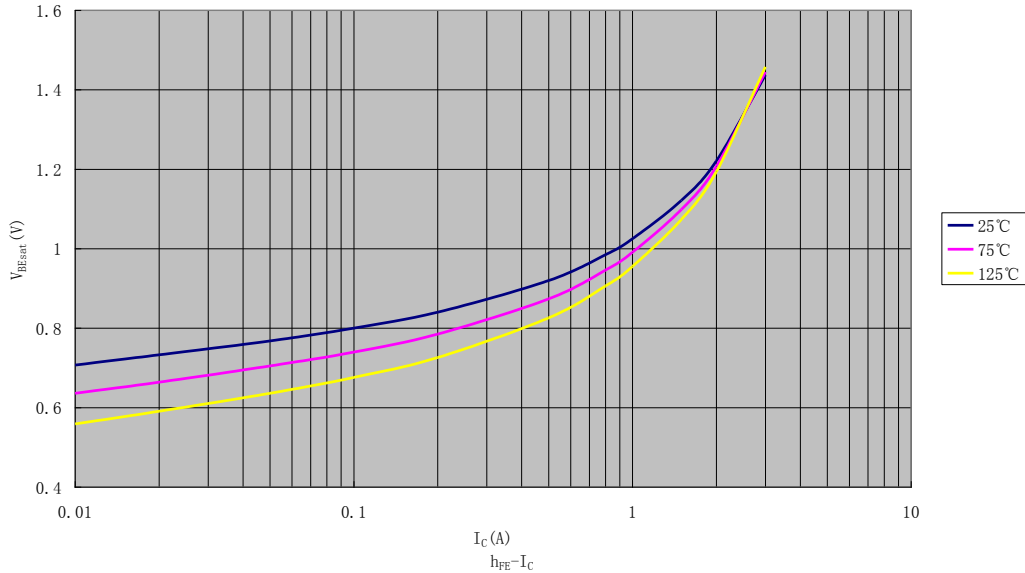


江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN037

高频放大环境额定双极型晶体管

文件编号	XS-W-155
版本号	18-B1-06
页码	3/3

$V_{BEsat}-I_C$



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：<http://www.xs-elec.com>
传真：(0510) 86851532